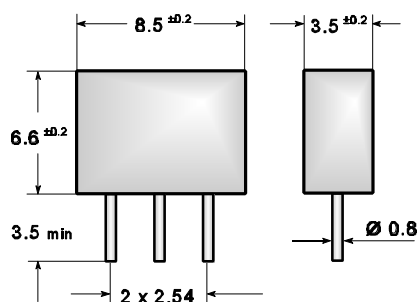
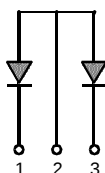


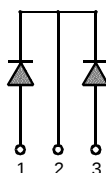
Rectifier Arrays



Dimensions / Maße in mm



"DAP": com. anodes / gemeinsame Anode



"DAN": com. kathodes / gemeinsame Kathode

Gleichrichter Sätze

Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	1.2 W
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	150 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	8.5 x 3.5 x 6.6 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	0,6 g

Standard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspg. V_R [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RM} [V]
DAN 208	100	150
DAP 208	100	150

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV}	1 A ¹⁾
Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave, superimposed on rated load, one diode only Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen, überlagert bei Nennlast, für eine Diode	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	10 A
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	– 50...+150°C – 50...+150°C

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics			Kennwerte	
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	V_F	$< 1.2\text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 100\text{ V}$	I_R	$< 10\text{ }\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	$< 45\text{ K/W}^1)$

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden